(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-241607 (P2000-241607A)

(43)公開日 平成12年9月8日(2000.9.8)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G 0 2 B 3/00		G 0 2 B 3/00	A 4F213
B 2 9 D 11/00		B 2 9 D 11/00	
# B 2 9 K 101:10			
105: 32			

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 12 頁)

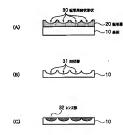
(21)出願番号	特願平11-40357	(71)出願人	000113263	
			ホーヤ株式会社	
(22)出順日	平成11年2月18日(1999.2.18)		東京都新宿区中落合2丁目7番5号	
		(72)発明者	松本 研二	
			東京都新宿区中落合2丁目7番5号ホーヤ	
			株式会社内	
		(72)発明者	細田 啓次	
			東京都新宿区中落合2丁目7番5号ホーヤ	
			株式会社内	
		(74)代理人	100091362	
			弁理士 阿仁屋 節雄 (外2名)	
			鼻終再に締く	

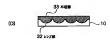
(54) 【発明の名称】 マイクロレンズアレイの形成方法およびマイクロレンズアレイ

(57)【要約】

【課題】 光学特性に優れ、かつ所望の光学特性を有するマイクロレンズアレイの形成方法及びマイクロレンズ アレイを提供する。

【解決手段】 基板10上に、該基板10上転空する複数の敵小空転写用回状形状30を有する電写層20を販 飯し、この転写層20の表面側からその表面形状を保存しながら全面をほぼ一様に除去する処理を転写層20がなぐなるまで統計ることによって、転写層20の転写用即状形状30を基板10に転写して基板に微小空叫状部31上形板し、次いで、これら酸小空回状部31上基板10の屈折率よりも高い屈折率を有する充填物質を充填してレンズ部32を形成することにより、マイクロレンズアレイを得る





【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明な基板に複数の微小な凹状部を形成 する凹状部形成工程と、該凹状部形成工程によって形成 された凹状部に前記基板の屈折率よりも高い屈折率を有 する充填物質を充填してレンズ部を形成するレンズ部形 成工程とを有し、

1

前記凹状部形成工程は、複数の微小な転写用凹状形状を 有する転写層を前記基板上に形成する転写層形成工程 と、該転写層の形状を基板に転写して基板に複数の微小 な四状部を形成する転写工程とを有することを特徴とす 10 るマイクロレンズアレイの形成方法。

【請求項2】 請求項1に記載のマイクロレンズアレイ の形成方法において、

前記転写層形成工程は、前記転写層を構成する転写物質 層を前記基板上に形成し、該転写物質層上にマイクロレ ンズアレイの配列に応じた微小開口部を形成したレジス トマスクを形成し、該レジストマスクを介してエッチン グを行うことにより、前記転写物質層に複数の微小な転 写用凹状形状を形成して転写層を得る工程を含むことを 特徴とするマイクロレンズアレイの形成方法。

【請求項3】 請求項1に記載のマイクロレンズアレイ の形成方法において、

前記転写層形成工程が、マイクロレンズアレイの配列に 対応して壁状物を前記基板上に形成し、前記壁状物の間 に液状物を供給して転写用凹状形状を有する転写層を形 成する工程を含むことを特徴とするマイクロレンズアレ イの形成方法。

【請求項4】 請求項1に記載のマイクロレンズアレイ の形成方法において、

前記転写層形成工程は、前記基板上に感光性樹脂層を形 30 によって遮光される光を各画素に集光することができ、 成し、該感光性樹脂層に、マイクロレンズアレイ形状に 対応したパターンが形成されたフォトマスクを用い、該 フォトマスクと前記感光性樹脂層との間隔を20μm以 上離して露光、現像することにより、複数の微小な転写 用凹状形状を有する転写層を形成する工程を含むことを 特徴とするマイクロレンズアレイの形成方法。

【請求項5】 請求項1に記載のマイクロレンズアレイ の形成方法において、

前記転写層形成工程は、前記基板上に感光性樹脂層を形 成し、該感光性樹脂層に、マイクロレンズアレイ形状に 40 じた屈折率の分布によりレンズの効果を生じさせる屈折 対応したパターンが形成された階調マスクを用いて霰 光、現像することにより、複数の微小な転写用四状形状 を有する転写層を形成する工程を含むことを特徴とする マイクロレンズアレイの形成方法。

【請求項6】 請求項5に記載のマイクロレンズアレイ の形成方法において、

前記階調マスクが微小なドットで形成されてなることを 特徴とするマイクロレンズアレイの形成方法。

【請求項7】 請求項1ないし6のいずれかに記載のマ イクロレンズアレイの形成方法において、

前記転写層の形状を基板に転写する転写工程が、ドライ エッチングにより行われることを特徴とするマイクロレ ンズアレイの形成方法。

【請求項8】 請求項7に記載のマイクロレンズアレイ の形成方法において、

前記転写工程におけるドライエッチングの速度が前記基 板のドライエッチング速度と前記転写層のドライエッチ ング速度とで異なることを特徴とするマイクロレンズア レイの形成方法。

【請求項9】 請求項1ないし8のいずれかに記載のマ イクロレンズアレイの形成方法において、

前記基板が、複数の微小な凹状部を形成する凹状部形成 基板と、該凹状部形成基板を支持する支持基板とを有す ることを特徴とする請求項1及至特許請求項8記載のマ イクロレンズアレイの形成方法。

【請求項10】 請求項1ないし9のいずれかに記載の マイクロレンズアレイの形成方法で形成されたマイクロ レンズアレイ.

【発明の詳細な説明】

20 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はマイクロレンズアレ イの形成方法およびマイクロレンズアレイに関するもの である.

[00021

【従来の技術】マイクロレンズアレイは数百μm以下の 微小なレンズが一次元もしくは二次元にアレイ状に配列 したものであり、光エレクトロニクス分野において広く 知られている。例えば、液晶素子の各画素に対応したマ イクロレンズアレイを用いると、ブラックマトリックス

光利用効率を向上させることができる。(NIKKEI MICRODEVICES, (12) 129, (19 91), 青木 正、National Technical Report, 36, (3) Jun. 116(1990))。また、アレイ状に配列された光ファ イバーと受光素子の結合部にマイクロレンズアレイを使 用すると光受光効率を向上させることができる。

【0003】このようなマイクロレンズアレイは、 基板 上に微小な凸形状のレンズを形成するもの、イオンを含 む基板を別のイオン源と接触させてイオン交換により生 率分布型のマイクロレンズアレイ、基板に総小な凹型形 状を形成し、この凹型形状内に基板より屈折率の高い充 填物質を充填して凸レンズを形成する構造等が提案され

【0004】基板に微小な凹型形状を形成して凹型に基 板より屋折率の高い充填物質を充填して凸レンズを形成 する構造は、得られるマイクロレンズアレイの表面自体 は平坦に形成できるので、反射防止膜、干渉フィルタ

一、ピンホール等の光学素子との複合化や液晶素子との 50 張合わせ等が容易であり、製造上で極めて有利であると

3

いう利点有している。

【0005】基核に歳小な四型形状を形成してこの四部 に高展折率物質を充填して凸レンズを形成するマイクロ レンズアレイの形成方法としては、ウエットエッチング による方法が知られている。この方法はガラス等の基板 に微小開口部を有するエッチングマスクを形成し、かっ 被等のエッチング液中に浸漬し、硫小帰口部からエッチ ング液によって等方性ウエットエッチングを行い、ガラ ス等の基板に半球状四型形状を形成し、次いでエッチン グマスクを除えして、四型形状を形成し、次いでエッチン 10い充填物質を充填する方法である。なお、この充填物質 としては、ボリカーボネートやアクリルスチレン共重合 樹脂等の有機が一般的に知られている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、ウエットエッチングによるマイクロレンズアレイの形成方法では、等 方性エッチングのため形成できるマイクロレンズの形状 は、敵小閘口部の大きさで決定され、任意な形状のマイ クロレンズアレイの形成は極かて風難である。また、用 いる基板もエッチング流によりエッチングできる必要が 20 あり、基板を構成する材料も石英ガラス等の限られたも の上か使用できない。

【0007】本発明は、上述したマイクロレンスアレイ 形成方法およびマイクロレンスアレイの問題点に鑑みて をされたものであり、任意が形状を有するマイクロレン スアレイが形成でき、かつ用いる基板の材料も任意な材 料が選択できるマイクロレンスアレイの形成方法および 光学特性に優れたマイクロレンスアレイを提供すること を目的とする。

[00008]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するために第1の発明は、透明な基板に複数の敵小な凹状語を 形成する凹状語形成工程と、誤凹状語形成工程によって 形成された凹状語に前記基板の屋折率よりる高い屋折率 を有する充填物質を充填してレンズ部を形成するレンズ 語形成工程とを有し、前記叩は語形成工程は、複数の敵 小な宝写用凹状形状を有する框写層を前定基板上形成 する框写層形成上程と、該電写層の形状を基板に駆写し て透板に複数の敵小公型状態を形成する框写工程とを有 することを特徴とするマイクロレンズアレイの形成方法。40 である。

【000】第2の発明は、第1の発明にからなマイク ロレンズアレイの形成方法において、前記航写層形成工 程は、前記能写扇を構成する転写物質層を前記基板上に 形成し、試施写物質層上にマイクロレンズアレイの配列 に応じた流析-開口部を形成したレジストマスクを形成 し、該レジストマスクを介してエッチングを行うことに より、前記能写物質層に複数の微小な転写用凹状形状を 形成して転写廊を得る工程と含むことを特徴とするマイ クロレンズアレイの形成方法である。 【0010】第3の発明は、第1の発明にかからなマク ロレンズアレイの形成方法において、前記転写解形成工 程は、マイクロレンズアレク配列に対応して壁状物を 前記基板上に形成し、前記壁状物の間に流光物を供給し で転写用凹状形状を有する転写層を形成する工程を含む ことを特徴とするマイクロレンズアレイの形成方法であっ

4

【0011】第4の発明は、第1の発明にからなマイク ロレンズアレイの形成方法において、前記転与展形成工 程は、前記基板上に総光性樹脂附を形成し、該総光性樹 脂屑に、マイクロレンズアレイ形状に対応したパターン か野感をはたフォトマスクを用い、語マホトマスクと前 記感光性樹脂層との間隔を20μm以上離して霧光、現 像することにより、複数の微小を転写用凹状形没名すす 会転写解を挑放する工程を含むことを特徴とするマイク

【0012】第5の発明は、第1の発明にかかるマイクロレンズアレイの形成方法において、前記転写帽形成工程は、前記基板上に感光性樹脂層を形成し、該感光性樹脂を開発している。

ロレンズアレイの形成方法である。

20 脂層に、マイクロレンズアレイ形状に対応したパターン が形成された階調マスクを用いて露光、現像することに より、複数の微小空転写用四状形状を有する転写層を形 成する工程を含むことを特徴とするマイクロレンズアレ イの形成方法である。

【0013】第6の発明は、第5の発明にかかるマイク ロレンズアレイの形成方法において、前記階割マスクが 続小なドットで形成されてなることを特徴とするマイク ロレンズアレイの形成方法である。

【0014】第7の発明は、第1万至第6のいずれかの

30 発明にかかるマイクロレンズアレイの形成方法において、前記転写層の形状を基似に転写する転写工程が、ドライエッチングにより行われることを特徴とするマイクロレンズアレイの形成方法である。

【0015】第8の発明は、第7の発明にかかるマイク ロレンズアレイの形成方法において、前記転写工程にお けるドライエッチングの速度が前記基板のドライエッチ ング速度と前記転写層のドライエッチング速度とで異な ることを特徴とするマイクロレンズアレイの形成方法で まる

【0016】第9の発明は、第1月至第8のいずれかの 売明にかかるマイクロレンズアレイの形成方法におい て、前記基板が、複数の微小な凹柱部を形成する凹状部 形成基板と、該凹板部形成基板を支持する支持基板とを 有することを特徴とする請求項1及至時計請求項8記載 のマイクロレンズアレイの形成方法である。

【0017】第10の発明は、第1万至第10のいずれ かの発明にかかるマイクロレンズアレイの形成方法で形 成されたマイクロレンズアレイである。

[0018]

50 【 発明の実施の形態】 図1は本発明の実施の形態にかか

るマイクロレンズアレイの形成方法の説明理である。この実施の形態にかかるマイクロレンズアレイの形成方法 (1) 非然に、能法版工能等する複数の像小な凹状部の形状を有する転写層を形成する転写矩形成工程 (231(A)参照)と、(2)この転写層の形状を基礎に転写して基板に複数の版が中間は部を形成する転写工程 (231(B)参照)と、(3)この転写工程によって 形成された凹状部に基板の相が平よりも高い規が率を有る充填物質を定填してレンズ部形成工程 (21(C),(D)参照)とを有する。以下、図1を解にしながら実施の形態にかかるマイクロレンズアレイの形成方法を設明する

【0019】(1) 転写層形成工程

この工程は、基板10上に、該基板10に転写する複数 の強小な凹状の球面あるいは計球面形状を有する転写用 凹状形状30を有する転写層20を形成する転写層形成 工程である。

【0020】こで、基板10はマイクロレンズアレイ に用いる波長に対し透明であることが必要であり、AI の。基板で以の各板等の金属軟化物からなる基板、 SICやSIN、Mgド等のセラミック基板、シリコン 基板やGaAs基板、石英ガラスやアルミナシリケート ガラス等の各様がラス基板、ボリエチレンテレタレート (PET)やボリカーボネートやボリウレタンやエボ キシ樹脂等のアラスチェク基板、あるいはこれらの複合 基板等が値に対けまりた。

【0021】転写層20は、基板10上に転写物質層2 1(図2参照)を形成し、この転写物質層21に、転写 用凹状形状30を形成したものである。転写物質層21 は、転写用凹状形状30を形成できるボリエチレンテレ フタレート(PET)、ボリカーボネート、ボリウレタ ン、エボキン植脈、ボリイミド、ボリイミド海原体、ボ リビニルアルコールやとドロキシエチルセルロース等の 水溶性高分子等の有機高分子、あるいはこれらの複合材 料が適宜無好えれる。また、A120。令肌の受等の金 展酸化物、S1CやS1N等のセラミック、シリコン、 石英ガラスやアルミナシリケートガラス等の各種ガラス 等を用いることも可能である。

【00221 転写物質層21は、基板10上の全面に形成してもよく、また、マイクロレンズアレイを形成する 40 部位に部分的に形成してもよい、転写物質層21の形成方法は、スクリーン印刷、スセンコート、真空差着、スパッタ、CVD等公知の方法が用いられる。また、形成する転写物質限21の厚みは、所望するマイクロレンズアレイの形状により適宜決定されるが、0.05μmから100μm移跡が好まりか。

【0023】転写用凹状形状30の形成方法は、機械加工により形成する方法、凸型を有するプレス型を用いて 転写層上に加圧あるいは加熱と加圧により形成する方

転写層上に加圧あるいは加熱と加圧により形成する方 法、光硬化性樹脂を基板上に載置し凸型を有するアレス 50 液、アセトンや静骸ブチル等の有機溶剤等から選定され

【0024】図2は歳小桐口部を有するレジストマスク り を用いてエッチングによって転写用即状形状30を形成 する方法の説明風である。この方法は、まず、基板10 上に転写物質短21を形成する。次に、この転写物質短 21上にマイクロレンズアレイの配列にほじた歳小桐口 第3を設けたレジストマスク2を形成する。図2(A) 参照)、次に、このレジストマスク2をマスクにしてウ エットエッチングスはドライエッチングを行い、転写用 回状形状30を形成する(図2(B)参照)。次いで、 レジストマスク2を除去して装板10上に転写用20が 形成さおためのを得る(図2(C)参照)

【0025】ここで、レジストマスタ2は、歳り郷口部 3を介して敵小な転写用は頭凹型形状を転写層に形成す る工程で優きれない特料を避宜運定され、Au、Cr、 W、Ta等の金属まだは、ITOやMgOやAl:00 等の金属能が助、工杯さり間能やノボラック側部等の有 機化合物等が用いられる。歳小棚口部3の形状は野望す るマイクロレンズアレイの配置に対応して形成され、その間口部の大きさは、所望するマイクロレンズの径と同 じ大きさか、または小さい形状であることが必要であ

【0026】截小開口部3の形成方法は、レジストマス ク2を形成可能なインクを用い、スクリーン印刷や回版 印刷等の印刷により強い開口部3以外の部位にレジスト マスク2を形成する方法、差板10上金面にレジストマ スク2を形成する方持を形成し、フェトリソグラフィー の工程を用い敵小開口部3を形成する方法、微小開口部 3を形成する確位をあらかじめマスキングし役を面に レジストマスク3を形成する材料を形成し、マスキング した部位を除去し微小開口部3を形成する方法等が用い られる。

【0027】微小側口部3を介して行うウエットエッチングは、転写物質層21はエッチングするがレジストマスク2はエッチングでもがレジストマスク2はエッチングしないエッチング溶液に浸漬し、微小側口部3から転写物質層21の一部を等方的にエッチングすることによって行う。

【0028】この場合のエッチング落液としては、フッ 酸水溶液、硫酸水溶液、硝酸水溶液、建酸水溶液含また これらの酸水溶液の混合溶液からなる水溶液、炭酸ナト リウム水溶液、水酸化カリウム水溶液、水酸化ナトリウ ム水溶液、ヒドラジンやアミン化合物のアルカリ性溶 8. 【0029】微小開口部3を介して行うドライエッチン グは、転写物質層21をエッチングし、レジストマスク 2をエッチングしないエッチングガスを含有する気層中 で処理し、微小開口部3から転写層21の一部が等方工 ッチングされる工程を行う。このときの気層中のエッチ

ングガスとしては、CF4 、CHF3 、SF6 、N F: , C1: 等の成分を含むプラズマ反応性ガスが好適 である.

ストマスク2を構成する材料により適宜選択され、酸水 溶液、アルカリ溶液や有機溶剤によるレジストマスク2 の落解除去やドライエッチングによるレジストマスク? の除去等が用いられる。また、レジストマスク2は必ず

しも除去する必要はなく、マイクロレンズアレイの光路 に影響しない場合は除去工程は不要である。

【0031】図3は転写用凹状形状を有する転写層20 を形成する他の方法の説明図である。図3に示される方 法は、基板10上に、マイクロレンズアレイの配列に対 応して壁状物5を形成し(図3(A)参照)、少なくと もこれら壁状物5の間に液状物51を供給し、この液状 物を乾燥することにより転写用凹状形状30を有する転 写層20を形成するものである。

【0032】図3(A)において、壁状物5はマイクロ レンズアレイの配列に対応して形成され、その形状は4 角形、6角形、8角形等の多角形や円形で基板10上に 形成配置される。

【0033】壁状物5は、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリカーボネート、ポリウレタン、エポキ シ樹脂、ボリイミド、ボリイミド前駆体、ボリビニルア 30 ルコールやヒドロキシエチルセルロース等の水溶件高分 子等の有機高分子、あるいはこれらの複合材料が適宜資 択される。また、A 12 03 やMg O等の金属酸化物。 SiCやSiN等のセラミック、シリコン、石英ガラス やアルミナシリケートガラス等の各種ガラス等を用いる ことも可能である。

【0034】壁状物5の形成方法は、壁状物5を形成可 能なインクを用い、スクリーン印刷や凹版印刷等の印刷 により形成する方法、基板10上全面に壁状物5を形成 する材料を形成し、フォトリソグラフィーの工程を用い 40 壁状物 5 を形成する方法、壁状物 5 を形成する部位をあ らかじめマスキングした谷全面に壁状物5を形成する材 料を形成しマスキングした部位を除去し壁状物5を形成 する方法等が用いられる。

【0035】液状物5は、揮発性溶液に不揮発性物質が 溶解されてなるものであり、ゾルゲル溶液や有機高分子 を溶剤に溶解した溶液が有効である。

【0036】また、壁状物5内に液状物51を供給する 方法としては、基板10上面に液状物を塗布する方法を 用いることができる。基板10上面に液状物を塗布する 50 れる方法は、転写物質層としての感光性樹脂層7が形成

方法としては、スクリーン印刷、カーテンコート、ディ ッピング法、スピンコート等の方法が好ましい。液状物 を塗布・乾燥することにより、液状物の表面張力により 壁状物5の壁面に球面状あるいは非球面状の凹状形状が 形成される。なお、その場合、壁状物5の上にも多少の 液状物51が残ってもよい。

【0037】マイクロレンズアレイの配列に対応した壁 状物5を基板10上に形成後、該壁状物全面に液状物5 1を塗布後乾燥することにより微小な転写用凹状形状を 【0030】レジストマスク2を除去する方法は、レジ 10 形成する方法をとることにより、凸型を有するプレス型 等を用いずに転写用凹状形状30を形成できるため、高 精細な転写用凹状形状が効率よく形成できる。

> 【0038】図4は転写用凹状形状を有する転写層20 を形成するさらに他の方法の説明図である。図4に示さ れる方法は、転写物質層としての感光性樹脂層 7 が形成 された基板10上にマイクロレンズアレイの配列及び形 状に対応した微細パターンが形成されたフォトマスク8 3を、基板10の表面から20µm以上の間隔をおいて 載置し、露光した後、現像することにより、転写用凹状 形状30を有する転写層20を得るものである。

【0039】感光性樹脂7はプリント基板や半導体製造 工程等で使用されている公知の感光性樹脂が使用でき、 基板10に形成する方法もスクリーン印刷、カーテンコ ート、ディッピング法、スピンコート等公知の方法が用 いられる。フォトマスク83は、ガラスやプラスチック 等の透明支持体に光を透過する部分と遮光する部分を形 成したものであり、感光性樹脂層7として光分解性感光 性樹脂を用いた場合は、転写用凹状形状30を形成する 部分に光が透過するフォトマスクを用い、光重合性感光

件樹脂を用いた場合は、転写用凹状形状30を形成する 部分に光が透過しないフォトマスクを用いる必要があ

【0040】ここで、感光性樹脂層7とフォトマスク8 3の間隔を20μm以上開けることにより、透過光が回 折し、マイクロレンズを形成する中心部分と周辺部分に 光量の差が生じる。上述の様に感光性樹脂層を形成し2 0 μm以上の間隔を開けて露光した感光性樹脂層7を現 像液で現像することにより、転写用凹状形状30が得ら

【0041】ここで、感光性樹脂層7とフォトマスク8 3の間隔は20 mm以上開ける必要があるが、広く開け 過ぎると同析光量が多くなり、転写用四状形状30の形 状が形成できなくなる。この間隔は用いる露光装置に依 存するが、200μm以下にすることが好ましい。この 方法によれば、凸型を有するプレス型等を用いずに転写 用門状形状30を形成できるため、高精細な転写用門状 形状を効率よく形成できる。

【0042】図5は転写用四状形状を有する転写層20 を形成するさらに他の方法の説明図である。図5に示さ 9

された基板10トにマイクロレンズアレイの配列及び形 状に対応した微細パターンが形成された階調マスク84 を、基板10の表面に載置し(図5(A)参照)、露光 した後、現像することにより、転写用四状形状30を有 する転写層20を得る(図5(B)参照)ものである。 【0043】感光性樹脂7は、プリント基板や半導体製 造工程等で使用されている公知の感光性樹脂が使用で き、基板10に形成する方法もスクリーン印刷、カーテ ンコート, ディッピング法、スピンコート等公知の方法 が用いられる。

【0044】階調マスク84は、ガラスやプラスチック 等の透明支持体に光を透過する部分と遮光する部分を形 成したものであり、図5(C)に示す様にマイクロレン ズアレイの各マイクロレンズに対応する部分が光透過量 が段階的に変化する構成である。ここで、光透過率を段 階的に変化させる階調マスクは、遮光部を形成するCr 等の材料の厚みを変化させ、透過量を段階的に変化させ る構成、光透過量が異なる材料を順次形成する構成であ 8.

性樹脂 7 の解像度と同程度以下の微小なドットを用い、 この微小なドットを形成する密度を順次変化させ、光透 過量を段階的に変化させる構成が有効である。

【0046】また、階調マスク84は、感光性樹脂層7 として光分解性感光性樹脂を用いた場合は、転写用球面 四型形状34を形成する部分に段階的に光が透過するフ ォトマスクを用い、光重合性感光性樹脂を用いた場合 は、転写用凹状形状30を形成する部分に段階的に光が 透過しない階調マスクを用いる必要がある。

調マスク84を用いて震光した感光性樹脂層7を現像液 で現像することにより、転写用凹状形状30が得られ 3.

【0048】この場合、階調マスク84を用いることに より、光透過量が段階的に変化し、感光性樹脂層7の現 像量が段階的に変化し、転写用四状形状30が得られ、 る。さらに、階調マスク84の光透渦量の変化を制御す ることにより、転写用凹状形状30の形状を球面とする ことも非球面とすることも可能である。

【0049】上述の階調マスクを用いる方法は、凸型を 40 る。 有するプレス型等を用いずに転写用四状形状30を高精 度でかつ効率よく形成できるという利点を有するほか に、転写用凹状形状として、球面形状のほかに非球面状 のものも容易かつ効率よく形成することを可能にすると いう優れた利点を有する。

【0050】(2) 転写工程

この工程は、上述の転写層形成工程で形成された転写層 20の形状を基板10に転写して基板に複数の微小な凹 状部31 (図1 (B) 参照) を形成する工程である。こ こで、転写用凹状形状30を基板10に転写する方法と 50 適宜選択され、液状物質を塗布して硬化する方法、溶融

しては、エッチング法、サンドブラスト法、もしくは、 イオンミリング等による方法が可能である。

【0051】この転写工程に用いる方法としては、特 に、ドライエッチング法を用いれば、精度よく、且つ効 率的に複数の微小な凹状部31を基板10に形成でき る。ドライエッチングの中でも、CF4 、CHF3 、S Fs , NF3 , C 12 等の反応性ガスを用いるリアクテ ィブイオンエッチングが好適である。この場合、転写用 四状形状30のドライエッチング速度と基板10のドラ 10 イエッチング速度が異なる条件でエッチングすると、転 写用凹状形状30の形状を増幅した微小な凹状部31を

形成することができ、マイクロレンズアレイの光学特性

を制御することが可能である。 【0052】この占をさらに具体的にいえば、転写用門 状形状30のドライエッチング速度より基板10のドラ イエッチング速度が2倍早い場合、基板10に形成され る微小な凹状部31の深さは、転写用凹状形状30の深 さの2倍になる。また、転写用凹形状30のドライエッ チング速度に対して基板10のドライエッチング速度が 【0045】また、より好ましい階調マスクして、感光 20 0.5倍である場合、基板10に形成される微小な凹状 部31の深さは、転写用凹状形状30の深さの0.5倍 になる.

> 【0053】また、転写用凹状形状30のドライエッチ ング速度と基板10のドライエッチング速度の比をドラ イエッチング工程で変化させると、非球面な曲率を有す る微小な凹状部31が得られ、非球面なマイクロレンズ アレイが形成でき、マイクロレンズアレイの光学特性を 制御することが可能である。

【0054】ここで、転写用凹状形状30のドライエッ 【0047】上述の様に、感光性樹脂層7を形成し、階 30 チング速度と基板10のドライエッチング速度は、用い る基板10の材質と、転写層20の材質の組み合わせに より変化させることができる。また、ドライエッチング の方法。使用するガス種等のドライエッチングの条件に より変化させることができる。

【0055】(3)レンズ部形成工程

この工程は 上記四状部形成工程によって形成された複 数の微小な凹状部31に基板10の屋折率よりも高い屋 折率を有する充填物質を充填してそれぞれレンズ部32 を形成し、マイクロレンズアレイを形成する工程であ

【0056】基板10上り屋折率の高い充填物質は、マ イクロレンズアレイに用いる波長に対し、散乱が少な く、透明であることが必要であり、ポリエチレンテレフ **タレート(PET)やボリカーボネートやポリウレタン** やエポキシ樹脂等のプラスチック、あるいはこれらの複 合物質等が適宜選択される。特に、分子鎖中にSを含ん でいる有機物は屈折率が高く有効である。

【0057】基板10より屈折率の高い充填物質を凹状 部31に充填する方法は、用いる充填物質の特性により

して接着させる方法、モノマーを供給し、熱又は光で重 合させる方法等が用いられる。なお、レンズ部32を形 成した後には、形成した面を研磨して平坦にすることも 好ましい。

【0058】また、充填物質を凹状部31に充填する態 様としては、図1 (C)に示した様に、基板10の凹状 部31内にのみ充填物質を充填する態様のほかに、図1 (D) に示した様に、凹状部31内に充填物質を充填す ると同時に、基板10の表面上にも充填物質を塗布し、 充填物質による平坦部33を形成するようにしてもよ W.

【0059】なお、図6に示したように、基板10の裏 面に、該基板10の機械的強度を補強するために支持基 板11を取り付けることも好ましい。これによれば、基 板10の材質として機械的強度による制約を受ける事な く、門状部31の形成の容易性のみを考慮に入れて選択 することができるから、より適切な材料を選ぶことが可 能となる。この場合、基板10及び支持基板11は、用 いる光に透明である必要があり、基板10は凹状部31 を形成し易い樹脂等の有機高分子材料が好ましく、支持 基板11は機械的強度が強いセラミックスやガラスが好 適である.

【0060】上述のマイクロレンズアレイの形成方法で 形成されたマイクロレンズアレイは、高精度であり、光 学特性に優れ、かつ、平板なマイクロレンズアレイが形 成でき、他の光学素子との集積化が容易である。本発明 のマイクロレンズアレイの形成方法およびマイクロレン ズアレイは、液晶素子上に形成されるマイクロレンズア レイや光ファイバーと受光素子の結合部使用されるマイ クロレンズアレイ以外にもレーザーディスク、コンパク 30 トディスク 光磁気ディスク等の光ピックアップ用焦光 レンズ、一次元イメージセンサーやLEDプリンターの 結合素子等の光エレクトロニクス分野においても利用で きる。

【0061】次に、本発明を実施例によりさらに詳細に 説明する。

(実施例1)図7は本発明の実施例1にかかるマイクロ レンズアレイの形成方法の説明図である。以下、図7を 参照にしながら実施例1を説明する。

【0062】厚み1、1mmの無アルカリガラス(NA 40 40: HOYA株式会社製) からなる基板10 Fに転写 層20としてポリイミド前駆体(商品名:セミコファイ ン811株式会社東レ製)を塗布し、その上にレジスト マスク2を構成するフォトレジスト(商品名: AZ13 50; クラリアントジャバン製) を塗布し、微小開口部 形成用フォトマスクを用い露光し、アルカリ現像液で現 像することにより、微小開口部3を形成するとともに、 この微小開口部3を通じて前記ポリイミド前駆体の転写 **層20の一部を前記アルカリ現像液で溶解することによ** り、転写用凹状形状30を転写層20に形成した(図7 50 は、転写用凹状形状30のエッチングレートの2.5倍

(A) 参昭).

【0063】この場合、微小開口部3の配置は、80μ mビッチで40mm角内に格子状に配置されており、形 成された転写用凹状形状30の深さは1μmであった。 次に、酢酸ブチルを用いレジストマスク3を溶解除去さ サ. 深さ1 umの微小な転写用円状形状30が形成され た転写層20を有する基板10を得た(図7(B)参 照)。

【0064】次に、転写層20の転写用凹状形状30を 10 形成した面側から、平均粒子径20μmのSiC研磨剤 を用いてサンドブラスト装置で全面を研削を行ない、転 写用四状形状30を保存しながら研削を続け、これを転 写層20がなくなるまで行なうことにより、転写層20 の転写用四状形状30を基板10に転写し、基板10 に、深さ1.5µmの微小な凹状部31を多数形成した (図7 (C)参照)。

【0065】次に、基板10の凹状部31が形成された 面に対し、基板10より屈折率の高い物質からなる充填 物質であるポリサルホン(例えば、アモコパフォーマン スプロダクツ社の商品名UDEL P-1700等)を 塗布し、200℃で加熱熔着させ、冷却後形成面を研磨 図7(D)に示されるマイクロレンズアレイを得

【0066】上述のマイクロレンズアレイは焦点距離の ばらつきが±18%で極めて良好なマイクロレンズアレ

イであった。 【0067】(実施例2)図8は本発明の実施例2にか かるマイクロレンズアレイの形成方法の説明図である。

以下、図8を参照にしながら実施例2を説明する。 【0068】厚み0、7mmの石英ガラスからなる基板 10 Fにフォトレジスト(商品名: A Z 1 3 5 0: クラ リアントジャパン製)) を 0 , 8 μ mの厚みでスピンコ ートにより途布して感光性樹脂層7を形成し、この感光 性樹脂層7にマイクロレンズアレイの配列部分が光透過 するフォトマスク83を用いて露光した(図8(A)参

【0069】次に、この感光性樹脂層7をアルカリ現像 液で現像後、200℃1時間加熱することによって、幅 1 μm、半径24 μm、高さ0、7 μmの円形の壁状物 5を得た(図8(B)参照)。次に、ポリビニルアルコ ール5w±%を含む水溶液を壁状物7を形成した基板上 10にディップコートし、60℃で2時間乾燥し、図8 (C)に示される転写用門状形状30を基板10上に形 成した。

【0070】次に、基板10を平行平板型プラズマエッ チング装置を用い、CHF。プラズマガス中40分間エ ッチングを行い、転写用凹状形状30の形状を基板10 に転写し微小な多数の凹状部31を形成した(図8

(D)参照)。この場合、基板10のエッチングレート

であり、微小な凹状部31の深さは1,4 µmであっ

【0071】次に、微小な四状部31を形成した面に対 し、基板より屈折率の高い充填物質である熱硬化性クレ ゾヘルノボラック型エポキシ樹脂を塗布し、マイクロレ ンズアレイを得た(図8(E)参照)。このマイクロレ ンズアレイは焦点距離のばらつきが±8%で極めて良好 であった。

【 0 0 7 2 】 (実施例3) 図9は木発明の実施例3にか かるマイクロレンズアレイの形成方法の説明図である。 以下、図9を参照にしながら実施例3を説明する。

【0073】厚み0、7mmの石英ガラスからなる基板 10上に感光性樹脂(商品名: AZ1350; クラリア ントジャパン製))を1.2 μ mの厚みでスピンコート により塗布し、マイクロレンズアレイの配列部分が光透 過するフォトマスクを用い、フォトマスクと感光性樹脂 層との間隔を22μm 離し、露光後、アルカリ現像液で 現像し、幅2μm、半径12μmの転写用凹状形状30 を得た(図9(A)参昭).

【0074】次に、基板10を平行平板型プラズマエッ チング装置を用い、CF4 プラズマガス中40分間エッ チングを行い 転写用四状形状30の形状を基板10に 転写し、微小な凹状部31を形成した(図9(B)参 昭)、基板10のエッチングレートは、転写用四状形状 30のエッチングレートの0.8倍であり、微小な球面 凹状部31の深さは0.96μmであった。

【0075】微小な凹状部31を形成した面に対し、基 板10より屈折率の高い充填物質であるSiをスパッタ 法により形成し、形成面を研磨し平滑にし、マイクロレ ンズアレイを得た(図9(C)参照)。このマイクロレ 30 ンズアレイは隹占距離のばらつきは+7%で極めて良好 なマイクロレンズアレイが形成できた。

【0076】(実施例4)図10は本発明の実施例4に かかるマイクロレンズアレイの形成方法の説明図であ る。以下、図10を参照にしながら実施例4を説明す

【0077】Si支持基板11上に100μmフッ素樹 脂からなる基板10を形成し、その上に感光性樹脂(商 品名: CD-500; アサヒ化学研究所製) を2. 4 μ mの厚みでスクリーン印刷により塗布し、感光性樹脂層 40 7を形成し、マイクロレンズアレイの配列部分の光透渦 率が段階的に変化する階調マスク84を用いて露光した (図10(A)参照)。

【0078】次に、この基板を、35℃に加温した1% 炭酸ナトリュウム水溶液からなる現像液で現像後し、半 径63 μm、深さ1、8 μmの転写用門状形状30を形 成した (図10(B)参照)。なお、階調マスク84 は、図10(E)に示した様に、マイクロレンズアレイ の各マイクロレンズ配列部分に対し、マイクロレンズ中 央10μmの円部分の光透過率は0%、その外側5μm 50 用凹状形状を形成することを可能にしている。

の円部分は光透過率は5%、その外側5 µm の円部分は 光透過率は10%、その外側5µmの円部分は光透過率 は20%、その外側5 µmの円部分は光透過率は30 %、その外側5μmの円部分は光透過率は50%、その 外側2μmの円部分は光透過率は100%である階調を 有する階調マスクである。この階調84マスクは2μm のドットの配置密度で透過光量を制御してある。

【0079】次に、基板10を平行平板型プラズマエッ チング装置を用い、CH₁ とCF₄混合ガスのプラズマ 10 中40分間エッチングを行い、転写用凹状形状30の形 状を基板10に転写し、微小な凹状部31を形成した (図10(C)参照)。基板10のエッチングレート は、転写用凹状形状30のエッチングレートの3.8倍 であり、微小な四状部31の深さは6、8 umであっ

【0080】次に、微小次凹状部31を形成した面に対 し、基板10より屈折率の高い高屈折充填物質である 2,5-ジメチルメルカプト-1,4-ジチアン1Mと ビドロキシエチルメタクリレート2M、光開始剤(チバ 20 ガイギ株式会社製の商品名イルガキュア184等)3w t%からなる光硬化樹脂をスピンコートで塗布し、ガラ ス板からなる対向基板12と張合わせて、高圧水灯を用 い1 J/cm2の紫外線を照射し、マイクロレンズアレ イを得た(図10(D)参照)。このマイクロレンズア レイは焦点距離のばらつきが±7%で極めて良好なもの

であった. [0081]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明は、透明な 基板に複数の微小な凹状部を形成する凹状部形成工程 と、該四状部形成工程によって形成された凹状部に前記 基板の配折率よりも高い配折率を有する充造物質を充造 してレンズ部を形成するレンズ部形成工程とを有し、前 記凹状部形成工程は、前記基板に転写する複数の微小な 転写用凹状形状を有する転写層を前記基板上に形成する 転写層形成工程と、この転写層の形状を基板に転写して 基板に複数の微小な凹状部を形成する転写工程とを有す ることを特徴とするもので、これにより、光学特性に優 れ、かつ任意の光学特性を有するマイクロレンズアレイ を効率よく形成することを可能にしている。

【0082】この場合、転写層形成工程として、転写物 質層上にマイクロレンズアレイの配列に応じた樹小開口 部を形成したレジストマスクを形成し、該微小園口部を 介して転写層物質層上に転写用凹状形状を形成する方法 を採用することにより効率よく転写用凹状形状を形成す ることを可能にしている。

【0083】また、転写層形成工程として、マイクロレ ンズアレイの配列に対応した壁状物を基板上に形成後。 壁状物全面に液状物を塗布後乾燥して微小な転写用凹状 形状を形成する方法を採用することにより効率よく転写

【0084】さらに、転写層形成工程として、基板上に 感光性樹脂層を形成し、マイクロレンズアレイの配列に 対応したフォトマスクと該感光性樹脂層との間隔を20 μm以上離して露光、現像して微小な転写用凹状形状を 形成する方法を採用することにより効率よく転写用凹状 形状を形成することを可能にしている。

【0085】また、上述の転写用凹状形状を基板に転写 する転写工程を、ドライエッチングにより行ない、さら に、転写層のドライエッチング速度と基板のドライエッ チング速度とを異ならしめることにより、転写用凹状形 10 【図4】転写層形成工程の説明図である。 状の形状を増幅した微小な凹状部を基板に形成したり。 あるいは、非球面な凹状部を形成することができ、マイ クロレンズアレイの光学特性を精密に制御することが可 能な極めて優れたマイクロレンズアレイの形成方法を得 ることを可能にしている。

【0086】さらに、前記基板を、微小な凹状部を形成 する基板とこれを機械的に支持する支持基板とで構成す ることにより、微小な凹状部を形成できる基板の材質の 選択度を飛躍的に広げることを可能にし、これにより、

16

している。 【0087】また、上述のマイクロレンズアレイの形成 方法によって形成されたマイクロレンズアレイは光学特

件に優れている。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかるマイクロレンズアレイの形成方 法の実施の形態の説明団である。

【図2】転写層形成工程の説明図である。

【図3】転写層形成工程の説明図である。

【図5】転写層形成工程の説明図である。

【図6】基板を支持基板で補強した例を示す図である。

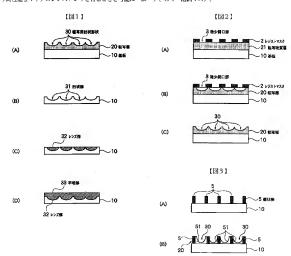
【図7】実施例1の説明図である。

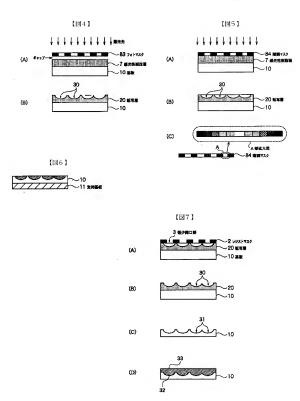
【図8】実施例2の説明図である。 【図9】実施例3の説明図である。

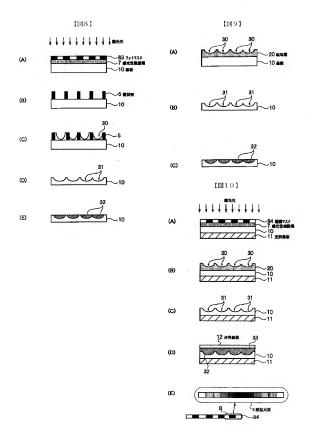
【図10】実施例4の説明図である。

【符号の説明】

10…基板、20…転写層、30…転写用凹状形状、3 1…微小な凹状部、32…レンズ部、83…フォトマス より高件能なマイクロレンズアレイを得ることを可能に 20 ク、84…階調マスク。







フロントページの続き

(72)発明者 佐藤 重男 東京都新宿区中落合2丁目7番5号ホーヤ 株式会社内

F ターム(参考) 4F213 AA44 AH74 WA02 WA53 WA56 WA58 WA86 WC02